

## 解説

## 問題 I

- (1) 電荷は半径  $a$  の導体球の表面に分布する。球対称のため、 $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r)\frac{\mathbf{r}}{r}$ ,  $\mathbf{D}(\mathbf{r}) = D(r)\frac{\mathbf{r}}{r}$ ,  $\mathbf{P}(\mathbf{r}) = P(r)\frac{\mathbf{r}}{r}$  と書ける。半径  $r$  の同心球の表面  $S$  に対して、電束密度に関するガウスの法則を適用する。 $S$  内の真電荷を  $q_t(r)$  と書くと

$$\iint_S D_n dS = \iint_S D(r) dS = D(r) \iint_S dS = 4\pi r^2 D(r) = q_t(r)$$

となる。

$$q_t(r) = \begin{cases} 0 & \dots & r < a \\ Q & \dots & a < r \end{cases}$$

より

$$D(r) = \begin{cases} 0 & \dots & r < a \\ \frac{Q}{4\pi r^2} & \dots & a < r \end{cases}$$

を得る。 $r < b, d < r$  で  $D(r) = \epsilon_0 E(r)$ ,  $b < r < d$  で  $D(r) = \epsilon(r) E(r)$  より,

$$E(r) = \begin{cases} 0 & \dots & r < a \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & \dots & a < r < b \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon(r)r^2} = \frac{Qr^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 d^4} & \dots & b < r < d \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & \dots & d < r \end{cases}$$

を得る。 $D(r) = \epsilon_0 E(r) + P(r)$  より

$$P(r) = \begin{cases} 0 & \dots & r < b \\ \frac{Q}{4\pi r^2} \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon(r)}\right) = \frac{Q}{4\pi r^2} \left(1 - \frac{r^4}{\epsilon d^4}\right) & \dots & b < r < d \\ 0 & \dots & d < r \end{cases}$$

を得る。

## (2) 解法 1

中心からの距離が  $r$  の位置での単位体積あたりの電界のエネルギーは  $u_E(r) = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{2} E(r) D(r)$  より、中心からの距離が  $r \sim r + dr$  の微小部分の体積は  $4\pi r^2 dr$  であるから、この微小部分の電界のエネルギーは  $4\pi r^2 u_E(r) dr$  となる。これより、

$$\begin{aligned} U_E &= \int_0^\infty 4\pi r^2 u_E(r) dr \\ &= \int_a^b 4\pi r^2 \frac{1}{2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{Q}{4\pi r^2} dr + \int_b^d 4\pi r^2 \frac{1}{2} \frac{Qr^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 d^4} \frac{Q}{4\pi r^2} dr + \int_d^\infty 4\pi r^2 \frac{1}{2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{Q}{4\pi r^2} dr \\ &= \int_a^b \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_b^d \frac{1}{2} \frac{Q^2 r^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 d^4} dr + \int_d^\infty \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left[ \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{3\epsilon d^3} (d^3 - b^3) + \frac{1}{d} \right] \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left[ \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{3\epsilon d} \left( 1 - \frac{b^3}{d^3} \right) + \frac{1}{d} \right] \end{aligned}$$

を得る.

解法 2

中心からの距離が  $r$  の位置の電位を  $\phi(r)$  とすると導体球の電位は  $\phi(a)$  となり, 導体球には電荷  $Q$  があるので,

$$\begin{aligned} U_E &= \frac{1}{2} Q \phi(a) = \frac{Q}{2} \int_a^\infty E(r) dr \\ &= \frac{Q}{2} \left[ \int_a^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_b^d \frac{Qr^2}{4\pi\epsilon_0 d^4} dr + \int_d^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \right] \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left[ \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{3\epsilon d^4} (d^3 - b^3) + \frac{1}{d} \right] \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left[ \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{3\epsilon d} \left( 1 - \frac{b^3}{d^3} \right) + \frac{1}{d} \right] \end{aligned}$$

を得る.

- (3) 誘電体表面の分極電荷密度  $\omega_P$  は誘電体表面の単位法線ベクトルを  $\mathbf{n}$  とするとき,  $\omega_P = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}$  で与えられる.  $r = b$  の表面では  $\mathbf{n} = -\mathbf{r}/r$ ,  $r = d$  の表面では  $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$  であるので,

$$\begin{aligned} \omega_P(r=b) &= -P(r=b) = -\frac{Q}{4\pi b^2} \left( 1 - \frac{b^4}{\epsilon d^4} \right), \\ \omega_P(r=d) &= P(r=d) = \frac{Q}{4\pi d^2} \left( 1 - \frac{1}{\epsilon} \right) \end{aligned}$$

を得る. 半径  $r$  の球内の分極電荷  $Q_P(r)$  は, 半径  $r$  の球面を  $S$  として

$$Q_P(r) = - \iint_S P(r) dS = -4\pi r^2 P(r)$$

で与えられる. これより,

$$q_P(r_1, r_2) = Q_P(r_2) - Q_P(r_1) = -4\pi r_2^2 P(r_2) + 4\pi r_1^2 P(r_1)$$

を得る. ここで  $b < r_1 < r_2 < d$  より,

$$q_P(r_1, r_2) = -4\pi r_2^2 \frac{Q}{4\pi r_2^2} \left( 1 - \frac{r_2^4}{\epsilon d^4} \right) + 4\pi r_1^2 \frac{Q}{4\pi r_1^2} \left( 1 - \frac{r_1^4}{\epsilon d^4} \right) = \frac{Q}{\epsilon} \left( \frac{r_2^4}{d^4} - \frac{r_1^4}{d^4} \right)$$

を得る.

おまけ

誘電体表面以外の全分極電荷は  $q_P(b, d) = \frac{Q}{\epsilon} \left( 1 - \frac{b^4}{d^4} \right)$  となる. 一方表面の分極電荷は,  $4\pi b^2 \omega_P(r=b) + 4\pi d^2 \omega_P(r=d) = -Q \left( 1 - \frac{b^4}{\epsilon d^4} \right) + Q \left( 1 - \frac{1}{\epsilon} \right) = -\frac{Q}{\epsilon} \left( 1 - \frac{b^4}{d^4} \right)$  となり,  $q_P(b, d)$  を打ち消す.

## 問題 II

(1)

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{H} &= \mathbf{i}_t + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \\ \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, \\ \operatorname{div} \mathbf{D} &= \rho_t.\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}-\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E}_0 &= 0, \\ -\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{B}_0 &= 0, \\ \mathbf{B}_0 &= -\frac{1}{v} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_0, \\ v &= \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}}.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}u(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = \frac{\varepsilon}{2} \mathbf{E}^2 + \frac{1}{2\mu} \mathbf{B}^2 = \frac{\varepsilon}{2} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) + \frac{1}{2\mu} B_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) \\ &= \frac{\varepsilon}{2} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) + \frac{1}{2\mu v^2} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) = \frac{\varepsilon}{2} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) + \frac{\varepsilon}{2} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) \\ &= \varepsilon E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) &= \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu v} \mathbf{E} \times (-\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}) \\ &= -\frac{1}{\mu v} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{E}) \hat{\mathbf{k}} - (-\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{k}}) \mathbf{E} = -\frac{1}{\mu v} E^2 \hat{\mathbf{k}} = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) \hat{\mathbf{k}}.\end{aligned}$$

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) \hat{\mathbf{k}} = -v \varepsilon E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) \hat{\mathbf{k}} = -v u(\mathbf{r}, t) \hat{\mathbf{k}}.$$

$$\therefore \mathbf{S} = -v u \hat{\mathbf{k}}.$$

## 問題 III

- (1) 対称性より  $\mathbf{B}(r, \varphi, z) = B(r) \mathbf{e}_\varphi$ ,  $\mathbf{H}(r, \varphi, z) = H(r) \mathbf{e}_\varphi$ ,  $\mathbf{J}(r, \varphi, z) = J(r) \mathbf{e}_\varphi$  と書ける. 半径  $r$  の同軸円 C に対して, 磁界に関するアンペールの法則を適用する. 真電流は導体を通る電流のみで, C を貫く真電流を  $I_C(r)$  とすると,

$$\oint_C \mathbf{H}_t ds = \oint_C H(r) ds = H(r) \oint_C ds = 2\pi r H(r) = I_C(r).$$

ここで、導体中を流れる真電流密度は  $\frac{I}{\pi a^2} \mathbf{e}_z$  であるので、 $r < a$  のとき  $I_C(r) = \frac{I}{\pi a^2} \pi r^2 = I \frac{r^2}{a^2}$ 、 $a < r$  のとき  $I_C(r) = I$  である。即ち、

$$I_C(r) = \begin{cases} \frac{Ir^2}{a^2} & \cdots \quad r < a \\ I & \cdots \quad a < r \end{cases}$$

となる。これより、

$$H(r) = \begin{cases} \frac{Ir}{2\pi a^2} & \cdots \quad r < a \\ \frac{I}{2\pi r} & \cdots \quad a < r \end{cases}$$

を得る。 $r < b$ 、 $d < r$  で  $B(r) = \mu_0 H(r)$ 、 $b < r < d$  で  $B(r) = \mu(r) H(r)$  より、

$$B(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 Ir}{2\pi a^2} & \cdots \quad r < a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & \cdots \quad a < r < b \\ \frac{\mu(r) I}{2\pi r} = \frac{\bar{\mu} \mu_0 I r^3}{2\pi b^4} & \cdots \quad b < r < d \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & \cdots \quad d < r \end{cases}$$

を得る。 $B(r) = \mu_0 H(r) + J(r)$  より、

$$J(r) = \begin{cases} 0 & \cdots \quad r < b \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left\{ \bar{\mu} \left( \frac{r}{b} \right)^4 - 1 \right\} & \cdots \quad b < r < d \\ 0 & \cdots \quad d < r \end{cases}$$

を得る。

- (2) 磁性体の内側の表面の磁性体内から外へ向かう単位法線ベクトルは  $-\mathbf{e}_r$ 、磁性体の外側の表面の磁性体内から外へ向かう単位法線ベクトルは  $\mathbf{e}_r$  であることから

$$\mathcal{I}_m(b, \varphi, z) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{J}(b, \varphi, z) \times \mathbf{n} = \frac{1}{\mu_0} J(b) \mathbf{e}_\varphi \times (-\mathbf{e}_r) = \frac{1}{\mu_0} J(b) \mathbf{e}_z = \frac{I}{2\pi b} (\bar{\mu} - 1) \mathbf{e}_z,$$

$$\mathcal{I}_m(d, \varphi, z) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{J}(d, \varphi, z) \times \mathbf{n} = \frac{1}{\mu_0} J(d) \mathbf{e}_\varphi \times \mathbf{e}_r = -\frac{1}{\mu_0} J(d) \mathbf{e}_z = -\frac{I}{2\pi d} \left\{ \bar{\mu} \left( \frac{d}{b} \right)^4 - 1 \right\} \mathbf{e}_z.$$

- (3)  $\mathbf{i}_m = \frac{1}{\mu_0} \text{rot} \mathbf{J}$  の積分形は、閉曲線  $C$  を縁とする面  $S$  に対し、 $\iint_S \mathbf{i}_m \cdot \mathbf{n} dS = \frac{1}{\mu_0} \oint_C J_t ds$  で与えられる。 $C$  を問題の半径  $r_1$  の円とすると、

$$I_m(r_1) = \frac{1}{\mu_0} \oint_C J(r_1) ds = \frac{1}{\mu_0} 2\pi r_1 J(r_1) = \begin{cases} 0 & \cdots \quad r < b \\ I \left\{ \bar{\mu} \left( \frac{r_1}{b} \right)^4 - 1 \right\} & \cdots \quad b < r < d \\ 0 & \cdots \quad d < r \end{cases}$$

を得る. あるいは, 半径  $r_1$  の円に対して  $B$  に関するアンペールの法則の積分形を用いて, 半径  $r_1$  の円を貫く全電流  $I(r_1)$  を求めると,

$$I(r_1) = \frac{1}{\mu_0} \oint_{\text{半径 } r_1 \text{ の円}} B(r_1) ds = \frac{1}{\mu_0} 2\pi r_1 B(r_1) = \begin{cases} \frac{Ir_1^2}{a^2} & \dots \quad r < a \\ I & \dots \quad a < r < b \\ \frac{\mu(r)I}{\mu_0} = \frac{\bar{\mu}Ir_1^4}{b^4} & \dots \quad b < r < d \\ I & \dots \quad d < r \end{cases}$$

を得る. 一方, 半径  $r_1$  の円を貫く真電流  $I_t(r_1)$  は

$$I_t(r) = \begin{cases} \frac{Ir^2}{a^2} & \dots \quad r < a \\ I & \dots \quad a < r \end{cases}$$

これより,

$$I_m(r_1) = I(r_1) - I_t(r_1) = \begin{cases} 0 & \dots \quad r < b \\ I \left\{ \bar{\mu} \left( \frac{r_1}{b} \right)^4 - 1 \right\} & \dots \quad b < r < d \\ 0 & \dots \quad d < r \end{cases}$$

を得る.

おまけ

表面以外の全磁化電流  $I_m$  は,  $I_m = \{I_m(d) - I_m(b)\} e_z = I\bar{\mu} \left\{ \left( \frac{d}{b} \right)^4 - 1 \right\} e_z$ . 一方,  $I_m(b, \varphi, z)$  と  $I_m(d, \varphi, z)$  は定ベクトルなので, それぞれ  $I_m(b, \varphi, z) = \hat{I}_m(b) e_z$ ,  $I_m(d, \varphi, z) = \hat{I}_m(d) e_z$  と書くと, 表面の磁化電流は  $2\pi b \hat{I}_m(b) e_z + 2\pi d \hat{I}_m(d) e_z = I\bar{\mu} \left\{ 1 - \left( \frac{d}{b} \right)^4 \right\} e_z$  となり  $I_m$  を打ち消す.

#### 問題 IV

- (1) 対称性より  $E(r, \varphi, z, t) = E(r, t) e_\varphi$ ,  $i(r, \varphi, z, t) = i(r, t) e_\varphi$  と書ける. 半径  $r$  の同軸円周  $C$  に対してファラデーの法則の積分形を適用する.  $C$  を縁とする円を  $S$  と書くと

$$\oint_C E_t ds = - \iint_S \frac{\partial B_{\text{ex},n}}{\partial t} dS.$$

ここで,

$$\oint_C E_t ds = \oint_C E(r, t) ds = E(r, t) \oint_C ds = 2\pi r E(r, t)$$



および

$$\begin{aligned} - \iint_S \frac{\partial B_{\text{ex},n}}{\partial t} dS &= - \iint_S \frac{\partial \{ \mathbf{B}_{\text{ex}}(r, \varphi, z, t) \cdot \mathbf{e}_z \}}{\partial t} dS = - \iint_S \frac{\partial (B_0 + \beta t)}{\partial t} dS \\ &= - \iint_S \beta dS = -\beta \iint_S dS = -\pi r^2 \beta \end{aligned}$$

より,

$$E(r, t) = -\frac{\beta r}{2} = E(r)$$

を得る.  $i(r, \varphi, z, t) = \sigma(r)E(r, \varphi, z, t)$  より,

$$i(r, t) = \sigma(r)E(r) = \sigma_0 \left(\frac{r}{a}\right)^4 \left(-\frac{\beta r}{2}\right) = -\frac{\sigma_0 \beta r^5}{2a^4} = i(r)$$

- (2) 電流も電界も時間に依存していない. 中心軸からの距離が  $r$  の位置での単位体積あたり単位時間あたりジュール熱  $p(r)$  は

$$p(r) = \sigma(r)E^2(r) = \sigma_0 \left(\frac{r}{a}\right)^4 \left(-\frac{\beta r}{2}\right)^2 = \frac{\sigma_0 \beta^2 r^6}{4a^4}.$$

単位長さの導体円柱棒の  $r \sim r + dr$  の微小部分の体積は  $2\pi r dr$  であるので, 単位長さあたり単位時間あたりジュール熱  $P(t)$  は

$$P(t) = \int_0^a p(r) 2\pi r dr = \int_0^a \frac{\sigma_0 \beta^2 r^6}{4a^4} 2\pi r dr = \frac{\sigma_0 \beta^2 \pi}{2a^4} \int_0^a r^7 dr = \frac{\sigma_0 \beta^2 \pi}{2a^4} \frac{a^8}{8} = \frac{\pi \sigma_0 \beta^2 a^4}{16} = P.$$

- (3) (1) で求めた電流密度分布は時間変化せず, ソレノイドの重ね合わせと考えられる. 従って  $\mathbf{B}'(r, \varphi, z, t) = B'(r)\mathbf{e}_z$  と書け,  $a < r$  に対し  $B'(r) = 0$  となる.  $R$  を  $a < R$  を満たす長さ,  $h$  を  $0 < h$  を満たす長さとする.  $\varphi = 0$  の面内で,  $A(r, 0, 0)$ ,  $B(r, 0, h)$ ,  $C(R, 0, h)$ ,  $D(R, 0, 0)$  の 4 点を取り, 閉曲線  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$  に対し, アンペールの法則を適用する. この閉曲線を  $C$ ,  $C$  を縁とする長方形  $ABCD$  を  $S$  と書くと

$$\oint_C \mathbf{B}'_t ds = \mu_0 \iint_S i_n dS.$$

ここで,

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{B}'_t ds &= \int_{A \rightarrow B} \mathbf{B}' \cdot \mathbf{e}_z ds + \int_{B \rightarrow C} \mathbf{B}' \cdot \mathbf{e}_r ds + \int_{C \rightarrow D} \mathbf{B}' \cdot (-\mathbf{e}_z) ds + \int_{D \rightarrow A} \mathbf{B}' \cdot (-\mathbf{e}_r) ds \\ &= \int_{A \rightarrow B} B'(r) ds = B'(r) \int_{A \rightarrow B} ds = B'(r)h. \end{aligned}$$

一方, 中心軸から距離  $r'$  の位置での電流密度は  $i(r')$ ,  $S$  中で電流密度が存在するのは  $r < r' < a$  の範囲で,  $S$  中で  $r' \sim r' + dr'$  の微小部分の面積は  $h dr'$  なので,

$$\begin{aligned} \mu_0 \iint_S i_n dS &= \mu_0 \iint_S \mathbf{i} \cdot \mathbf{e}_\varphi dS = \mu_0 \int_r^a i(r') h dr' = \mu_0 \int_r^a \left(-\frac{\sigma_0 \beta r'^5}{2a^4}\right) h dr' \\ &= -\mu_0 \frac{\sigma_0 \beta h}{2a^4} \int_r^a r'^5 dr' = -\mu_0 \frac{\sigma_0 \beta h}{2a^4} \frac{1}{6} (a^6 - r^6) = -\frac{\mu_0 \sigma_0 \beta a^2 h}{12} \left(1 - \frac{r^6}{a^6}\right). \end{aligned}$$

これらより

$$B'(r) = -\frac{\mu_0 \sigma_0 \beta a^2}{12} \left(1 - \frac{r^6}{a^6}\right).$$